

850nm 28Gbaud GaAs PD Chip $\phi 38\mu\text{m}$



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

带宽高达 28GHz/通道； $\phi 38\mu\text{m}$ 有效面积；850nm 高响应度；正面阳极/阴极焊盘

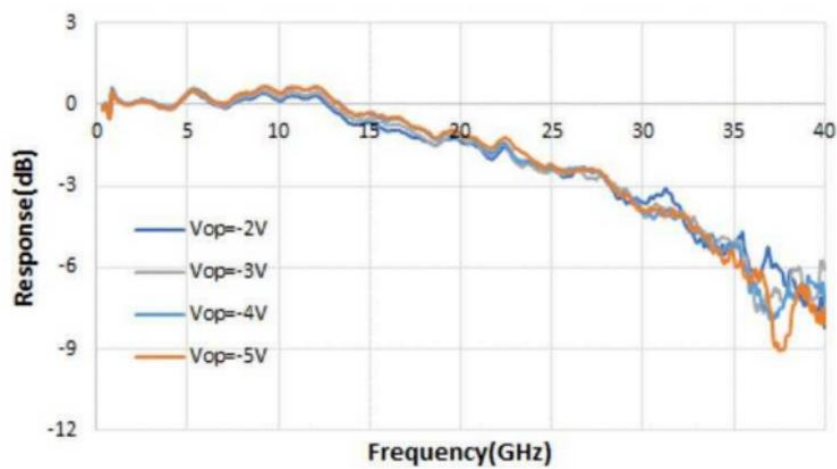
应用领域

50/200Gbps PAM4 | 112G SR4 AOC 接收机 | 4×25Gbps 光纤通道 | 短距离光网络

核心参数

无
无

详细参数



规格 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	$\lambda=850\text{nm}$
暗电流	I_D		0.01	0.05	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.07	0.10	pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		28		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		38		μm	
通道之间的中心间距(pitch)			250		μm	